# ⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A)

平3-127816

⑤lnt. Cl. \*

檢別配号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 G 11 B 7/125 7/14

A 8947-5D 8947-5D

8947-5D 7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

8発明の名称 マルチ電子源

②特 頭 平1-267575

夫

男

②出 願 平1(1989)10月13日

 ©発明者塚本 健

 ©発明者渡辺 信

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

⑫発 明 者 奥 貫 昌 彦 ⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑫代 理 人 弁理士 福森 久夫

#### 明和音

#### 1. 発明の名称

マルチ電子源

#### 2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ビームを放出する多数の電子機を 設列 および 視列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ビームを被照射体に照射すべ く各的記電子機を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子機において、前記総列に沿う前記電子機の の配列方向と前記模列に沿う前記電子機の 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子機。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産業上の利用分野】

本発明は、例えばレジスト指面用装置、 電子 ピーム記録用装置等のように、例えばショット キー型半導体電子源から放出する電子ピームを用 いて微磁かつ高密度の電子ピーム照射を行なう べく使用されるマルチ電子様に関するものであ る。

#### [從来技術]

従来、この後のマルチ電子原としては、例えば 米国特許第4259678号明細書、米国特許 4303930号明細書に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 像は、多数の電子環が緩列および検列のマトリク ス状に延載され、各前記電子高を順大の 配列方向(×方向)と数の配列方向(y方向)と のなす角度が度交したいわゆる単純マトリクスで 配置した検戒となっている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記投来技術の構成では、×方向とソ方向とのなす角度が直交しているので、例えば接照財体たる移動物体に向けて各電子部から電子ビームを放出する場合、電子ビームを移動物体上で追続的に照射させるようにしようとすると、各電子派は固定されていることから、移動物体の移動距離に応じて各電子源を一個ずつ個別に切如(いわゆる点頭次駆動制御)しなければなら

-85-

ない、接官すれば、在来技術の規定は、制有用に 競み込ませるデータが多肢になること、電子ビー ムの放出制御が複雑であること、電子ビームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制的される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動化体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目、 的とする。

## 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子ビームを放出する多数の電子器を設列とよび規列のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電子ビームを被照射体に照射すべく各前記電子環を顕立するようにして成るマルチ電子部において、前記級列に沿う前記電子環の配列方向と前記機列に沿う前記電子環の配列方向とを直交させないように設定したことを特徴とする。

## 【作用】

**基板上に配置されたマトリクス状電子部の横列** 

方向と展列方向とが直交しないので、名電子原からお助物は上に退議的に電子ビームを照射する場合、お助物体が一つの電子環とこれに顕接する電子限との関をお助する時間内に、一の列の全部のマトックス電子像を次々と駆動(鍵膜次駆動)させるという系統な制御で行なえる。

#### [実施例]

は、配額用の職段状に形成された板状電極 4 が名イオン往入低低 2 と交叉するように、すなわち級方向(各 y 方向 a 、 b 、 c 、 d … にいる。 したがって、 各 y 方向 a 、 b 、 c 、 d … におりる各 を 減速イオン注入領域 3 を 結ぶ線と 8 × 方向 A 、 B 、 C 、 D … におりる 8 高速度イオン注入領域 3 を 結ぶ線とのなす角度は 度交していない ( X 方向に 恰う線(X — X 線)と Y " — Y"線と

さらに、前記イオン注入領域2上には、前記高 誤歴イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく節状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

のなす角度をは90度よりも小である)。

各前記イオン往入領域2の機節の表面部にはそれぞれを機関拡散層7が形成され、各高機関拡散層7が形成され、各高機関拡散 層7上にはオーミックコンタクト部8が失々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電極9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極での機能にはそれぞれ電極11が提続されている。

従って、マトリクス状に配列された各電子根は、各×方向 A、 B、 C、 D …の所定の電極 9 と 各 y 方向 e、 b、 c、 d …の所定の電極 1 0 との間に逆パイアス電圧を印加すると、詐両電極の交点位置にある電子原である高速度イオン往入領域 3 が O N 状態となってアバランシェ増幅が生じ、当該高速度イオン注入領域 3 からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子源としてショットキー型半導体電子源を用いているが、特にショットキー型半導体電子源である必要はなく、PN接合、NEA (負の電子観和力)等の各種の半導体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に 照射し、連続的なビーム照射領域を形成するため の手順につき述べる。

まず、電子ビームが限制されるべき領域をマトリクス電子派に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電極2と各y方向。, b, c, d …の電極4との交点位置の電子派をON状態に

するかのFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電視2と各y方向 a . b . c . d … の電紙 4 との間への逆パイアス電圧印加によ り、 x 方向 A の各電子源から顧次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で作のX方向B, C. D…の電極2と各y方向 a. b. c. d…の電極4との関への逆パイアス電圧印加によりそれぞれ様限次駆動する。

全部のマトリクス位置の電子部を設動し終えた 技に、一の電子概とこれに開接する他の電子概と の間の距離だけ移動物体を提前の移動方向と値交 する方向に90度の方向に移動させ、再び各米方 向A、B、C、D・・と各y方向a、b、c、d・・ との交点位置の電子版を順次駆動する。かかる電 子原に動を破り返すことにより、移動物体の被照 射面を電子ビームにより全面照射することができる。

第4回は、マルチ電子環を電子ピームメモリに 通用した場合を示している。12は上記第1の実 庭例で述べたと同様な構成のマルチ半導体電子 悪、13はフォトダイオード、14は光を実空事 替へ入れるための導入部、15は光信号を送るた めのファイバー、16は高圧電響、17は電子部 を認動させるための電源、18は電子補配機媒体 である。故記録媒体18としては3iのMOS構 造、アモルファス状の3iOa構造、A22O。 酸および5iN膜等の多層膜構造のものがある。

上記のように様成されているので、マルチ電子 第12の変動用の制質信号は、塑送クロックと同 時に多重させ光信号として光ファイバー15を介 して伝達され、フォトダイオード13で再び電気 信号に戻される。マルチ電子銀12は高圧電源 16が接続されることにより高電圧になっている が、制気信号は光媒介としており、電気的に絶縁 されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子張12の光制器信号は、フォトダイ オード13で電気信号に変換され電気制御信号と しての複類制能信号となる。該制製信号はマルチ

7

・ 第5 図は、マルチ電子標を電子ビーム指語装置 に適用した場合を示している。同図において、マ ルチ半導体電子標1 2 は上記第1 の実施例で述べ たと同様な構成のものである。19 は半導体ウェ ハーであり、20 はレジスト上に描かれた電子 ビーム照射銀城である。

前記マルチ電子課12の整動手順は上記第2実施例とはぼ同様であるが、該電子源12の駆動制

8

年にウェハー19のステーク移動に応じ、接回すべき全エリアにおいて電子級12を原次練駆動を行う。

#### [発明の効果]

さらに、マルチ電子感をマトリクス状に構成して順次線駆動するため、移動体に同一の電子ピームの照射領域を形成しようとする場合、電子液が一次元配列である場合に比べて、移動体の移動達

成を低下することができ、数電子ビームの無射症 域が楕円変形するのを小さくすることができる。 また、電子ビームの無射領域を追談かつ高密度で 形成できるので、電子離メモリ、採用装置の個、 電子線ブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

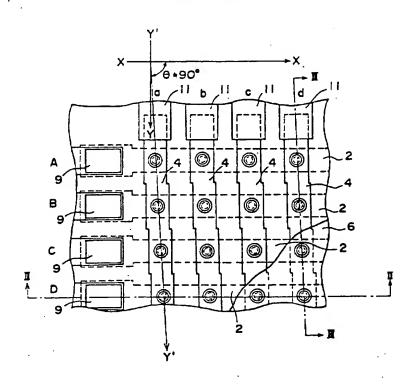
#### 4. 図面の簡単な説明

第1回乃至第3回は本発明の一実施例を示すものであり、第1回はマルチ電子原の平面図、第2回は第1回のII ― II 版に扱う断面図、第3回は第1回のII ― III 財に沿う断面図、第4回は電子ビームメモリ基屋への応用例を示す平面図、第5回は電子ビーム推面装置への応用例を示す平面図である。

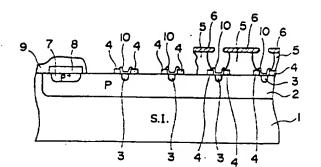
1 … 基板、3 … P型高速度イオン注入領域(電子源)、10 … シェットキー電極(電子版)、12 … マルチ電子版。

1 1

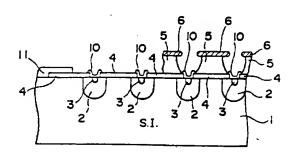
第 1 図



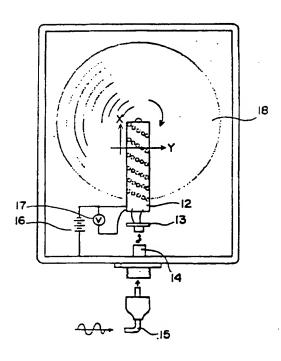
第 2 図



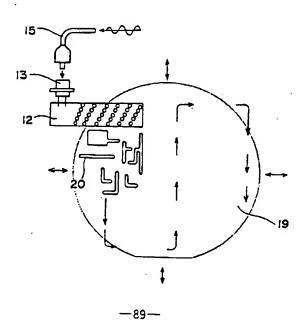
篮 3 03



## 第 4 図



第 5 図



REST AVAILABLE COPY



# 第 4 図

## 平成 2 年 2 月 6 日

## 特許庁長官

- 1.事件の表示 平成元年特許顯第267575号
- 2. 発明の名称 マルチ電子欲
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出版人

住 所 英京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称(100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

4. 代 理 人 平180 電話03(358)8540

住 所 東京都新宿区本塩町 12

四谷ニューマンション107

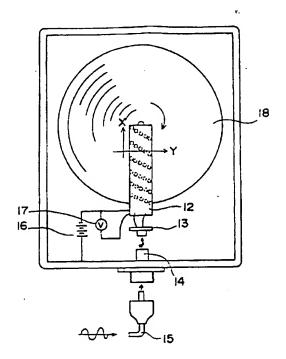
氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

5、補正命令の日付(発送日) 平成2年 1月30日

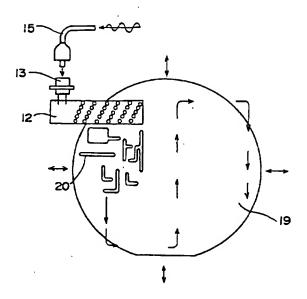
8、福正の対象 図面(第4,5図)

7. 福正の内容 別紙の通り





# 第 5 図



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43)Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/027

G11B 7/125 G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

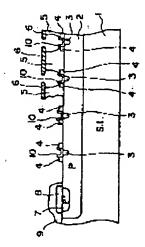
(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

WATANABE NOBUO OKUNUKI MASAHIKO

## (54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

# (57) Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row. CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of



rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

REST AVAILABLE COPY